Categoría	Componente Discreto	Cantidad (Unidades)
I. Microcontrolador y Periféricos Avanzados	Chip Microcontrolador ESP32 (ej. ESP32-D0WD-V3, ESP32-U4WDH)	1
·	Memoria Flash SPI NOR (ej. 4MB, 8MB o 16MB)	1
	Regulador de Voltaje de Precisión LDO (Low Dropout)	2-3
	Oscilador de Cristal (ej. 40MHz para ESP32)	1
II. Electrónica de Potencia de Alto Rendimiento	MOSFETs de Potencia de Carburo de Silicio (SiC) o Nitruro de Galio (GaN)	2-4
	Controladores de Puerta (Gate Drivers) Aislados de Alta Velocidad	2-4
	Diodos de Recuperación Rápida o Schottky de Potencia	2-4
	Inductores de Potencia Personalizados (Baja ESR, Alta Saturación)	2-3
	Condensadores de Enlace CC (DC-Link Capacitors) / Film Capacitors	4-6
	Condensadores Electrolíticos de Alta Capacidad (para filtrado general)	2-3
	Resistores de Sensado de Corriente de Precisión (Shunt Resistors)	2-3
III. Sistema de Gestión de Baterías (BMS) Avanzado	CI de Gestión de Celdas (Battery Management IC)	1
iii. Olotoffia de Ocotioff de Baterias (Bi 10/7tValizado	MOSFETs discretos para conmutación de carga/descarga del BMS	2-4
	Multiplexores / Switches Analógicos de Precisión	1-2
IV. Módulo de Potencia Pulsada Optimizado	Celdas de Supercapacitor Individuales (Alta C, Bajo ESR)	2-4
1V. Floduto de l'otericia i disada Optimizado	Resistores de Balanceo de Supercapacitor	4-8
V. Sensores de Alta Precisión y Aislamiento	CI de Sensor de Corriente de Efecto Hall (Aislado)	2
v. Serisores de Alla Precision y Alstarmento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
	CI de Sensor de Voltaje Aislado Termistores NTC de Precisión / RTDs	3-5
VII. Constitut Térration Anti-		2-3
VI. Gestión Térmica Activa	Sensores de Temperatura Digitales (ej. LM75, TMP102)	
VIII.1	CI Controlador de Ventilador / PWM	1
VII. Interconexión y Protección Avanzada	Optoacopladores / Aisladores Digitales (ej. ADuM1xxx, Si86xx)	4-8
	Conectores de Alta Corriente (ej. Anderson Powerpole, XT90)	4-6 pares
	Fusibles SMD (Surface Mount Device)	5-10 unidades
	Diodos Zener (varios voltajes)	5-10 unidades
	Diodos de Uso General (ej. 1N4148)	10-20 unidades
	Resistores SMD (surtido básico)	1 kit/caja
	Capacitores SMD (cerámicos, electrolíticos surtido básico)	1 kit/caja
VIII. Desarrollo y Prototipado (Adicional)	Circuitos Impresos (PCB) personalizados	5-10 unidades
	Notas Clave para la Cotización (Especificar con Proveedor)	
	El chip desnudo para un diseño de PCB personalizado. Permite máxima integración.	
	Para firmware avanzado y almacenamiento de datos de telemetría/configuración.	
	ej. analógicas, sensores) con un voltaje muy limpio y estable. Especificar voltaje de salida (ej. 3.3V, 5V)	y corriente (ej. 500mA - 1A).
Pa	ra la temporización principal del microcontrolador. Mayor precisión que los osciladores internos.	
omponente CLAVE para alta eficiencia y velocidad de conmutacio	ón. Especificar voltaje de ruptura (ej. 600V-1200V), corriente (ej. 20A-100A) y tipo de encapsulado (ej. TC	D-247, DFN). Considerar pares para topologías avanzadas.
Esencial para accionar los MOSFE	s SiC/GaN de forma eficiente y segura. Alta corriente de salida, baja latencia, aislamiento galvánico. (ej	j. ADuM4122, UCC21520).
Complementa	rios a los MOSFETs de SiC/GaN, minimizan pérdidas de conmutación. Especificar voltaje y corriente noi	minal.
ara convertidores de alta eficiencia y para el módulo de pulso. Es	pecificar valor de inductancia (ej. 100uH-1mH), corriente de saturación, resistencia serie (ESR) y tipo de	e material de núcleo (ej. ferrita de alta frecuencia, polvos de hierro).
Capacitores de polipropi	leno o cerámicos de alta capacidad y baja ESR, para filtrar el rizado y manejar las corrientes pulsantes e	en el bus de CC.
	Para el filtrado de bajo nivel de frecuencia en el bus de CC.	
F	Para mediciones de corriente de alta fidelidad. Baja deriva térmica y alta potencia (ej. 5W, 10W).	
Chip dedicado para mo	nitoreo multiceda. Permite balanceo, protección y monitoreo preciso. (ej. LTC6811 de Analog Devices, E	BQ769x0 de TI).
	Para implementar las funciones de protección de sobrecorriente y sobredescarga del BMS.	
Por	ra la lactura pracica da los voltajas da cada calda por al CI da gastión da caldas o un ADC externo	

Para la lectura precisa de los voltajes de cada celda por el CI de gestión de celdas o un ADC externo.

Para el efecto "pistón atómico" de alto rendimiento. Especificar voltaje por celda (ej. 2.7V, 3.0V) y capacitancia (ej. 500F, 1000F, 3000F). Requieren balanceo.

Para asegurar que los supercapacitores en serie se carguen y descarguen uniformemente.

Para mediciones de corriente de alta fidelidad con aislamiento galvánico (ej. ACS71205, ACS723). Rango de corriente adecuado (ej. +/- 50A, +/-100A).

Para mediciones precisas de voltajes de alto lado o aislados. (ej. AMC130x).

Para monitoreo de temperatura distribuido y preciso en batería, MOSFETs, inductores.

Para monitoreo de temperatura en puntos específicos de la PCB.

Para implementar un control inteligente y variable de la velocidad del ventilador.

CRUCIAL para aislamiento galvánico entre el microcontrolador y los circuitos de potencia/sensores de alto voltaje. Mejora la seguridad y la inmunidad al ruido.

Conectores robustos para las líneas de potencia principales.

Para protección precisa y compacta en la PCB.

Para protección contra sobretensión en circuitos de señal y como referencia.

Para propósitos generales de rectificación de señal, protección.

Para divisores de voltaje, pull-ups, limitación de corriente.

Para desacoplamiento, filtrado de ruido.

Fabricación de PCB a medida para integrar todos los componentes discretos.